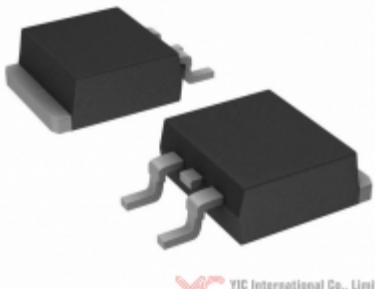

 life.augmented	<h2 style="color: red;">STB25NM60ND</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">STB25NM60ND</a>
 Image may be representation. See specs for product details.	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">STMicroelectronics</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 600V 21A D2PAK
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">STB25NM60ND.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 58787 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">STB25NM60ND</a>
Hersteller	<a href="#">STMicroelectronics</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 21A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	58787 pcs Stock
Serie	FDmesh™ II
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	150 °C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	160W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	21A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	160 mOhm @ 10.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	80nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2400pF @ 50V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Original-Reel®

STB25NM60ND ist neu im Original, Suche STB25NM60ND Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STB25NM60ND STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen. Anfrage STB25NM60ND: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>STB25NF06LAG</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 60V 25A D2PAK	 <b>STB26NM60N</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 20A D2PAK	 <b>STB25NM60N</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 21A D2PAK	 <b>STB26NM60ND</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 21A D2PAK
 <b>STB25NM50N</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 22A D2PAK	 <b>STB25NM50N-1</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 22A I2PAK	 <b>STB270N04</b> ST STB270N04 ST	 <b>STB25NS25Z</b> ST STB25NS25Z ST

### heiße Teile

Mehr

⊗ STB19NB20T4	↔ STB19NF20	⇒ STB19NM65N	D STB200N4F3	⇒ STB200NF03T4
⊣ STB200NF04	⊗ STB200NF04-1	D STB200NF04LT4	⇒ STB200NF04T4	⇒ STB20GC14.18750MHZ
⊗ STB20NF06LT4	⊣ STB20NM60	⊗ STB20NM60-1	↔ STB20NM60T4	⇒ STB21NK50Z
D STB21NK50ZT4	⊗ STB21NM50N	⊣ STB21NM50N-1	⊗ STB21NM60N-1	⇒ STB21NM60ND
⇒ STB22NE10LT4	↔ STB22NM60N	⊗ STB24NM60N	⊣ STB25NM50N-1	⇒ STB25NM60N
↔ STB25NS25Z	⇒ STB26NM60N	D STB26NM60ND	⊗ STB270N04-1	⊣ STB270N4F3
⊗ STB270N4F3-6	D STB27NM60ND	⇒ STB3015L	↔ STB30N10S	⇒ STB30N10T4
⊣ STB30N65M5	⊗ STB30NE06L	↔ STB30NE06LT4	⇒ STB30NF10T4	⇒ STB30NF20
⊗ STB30NS15	⊣ STB30NS15T4	⊗ STB32N65M5	D STB35N65M5	⇒ STB35NF10
↔ STB35NF10T4	⊗ STB36NF02L	⊣ STB36NF02L-TR	⊗ STB36NF03L	⇒ STB36NF03L-TR

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited